значения 2Å. Расчеты по НЭ демонстрируют большую чувствительность ΔG к изменению радиуса полости. Так при его увеличении всего на один ангстрем величина ΔG уменьшается на 2kT при $\lambda_{3(cav)} = 2$ Å для расчета по трехмодовой модели. Эти два обстоятельства открывают возможность объяснить стабилизацию иона в полости, особенно если ввести в рассмотрение дополнительное взаимодействие иона с зарядами белковых α -спиралей, направленных в центр полости, как это сделано в работе [2].

Таким образом, изучение эффекта нелокальности диэлектрического экранирования полей применительно к иону в сферической полости, окруженной низкополярной средой, показало, что нелокально-электростатические эффекты существенно влияют на стабилизацию иона в полости. Поэтому для решения фундаментально важной для понимания функционирования ионных каналов проблемы объяснения, каким образом ионы преодолевают выталкивающее действие биомембраны и стабилизируются в центре полостей внутри ее каналов, заполненных водой и окруженных слабополярной диэлектрической средой, необходимо учитывать NE-эффекты.

Приведем пример, как полученные нами результаты можно будет использовать для оценки селективности транспорта моновалентных ионов при их прохождении полостей, рассмотренных в данной работе. В формуле для потока J ионов типа і должен появиться множитель $u_i \exp(-\Delta G_i)$, где u_i — подвижность, а ΔG_i изменение свободной энергии перехода иона из неограниченного раствора в полость. Отношение таких множителей для моновалентных ионов равно селективности транспорта ионов разного типа. Нелокальноэлектростатические расчеты величин $\Delta G_{\rm i}$ представлены в данной работе. Таким образом, селективность транспорта различных моновалентных ионов зависит от параметров системы, изученной в данной работе, - соотношения диэлектрических проницаемостей полости и ее окружения, а также радиуса полости.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Методы нелокальной электростатики для пространственно ограниченных сред. Соотношения для подхода, основанного на обратном диэлектрическом приближении (IDA) [38]

Метод обратного диэлектрического приближения был разработан М.А. Воротынцевым (M.A. Vorotyntsev) с соавторами в [38–40]. В связи с тем, что он имеет решающее значение для получения результатов данной работы, целесообразно кратко обсудить его основные моменты.

При определенных условиях, установленных в работе [38] (см. также Приложение 2 в книге [21]), индукция D(r) тождественно совпадает с полем в вакууме $G_{\text{vac}}(r)$, которое создается той же системой внешних зарядов $\rho(r)$, а именно:

- 1. Для локального однородного диэлектрика: поверхности всех непроводящих полостей должны быть эквипотенциальными поверхностями поля G_{vac} . Тогда $D(r) = G_{\text{vac}}(r)$.
- 2. Для локального неоднородного диэлектрика: если $\varepsilon(r)$ меняется на границе скачком, то должно выполняться условие для локального однородного диэлектрика (поверхности всех непроводящих полостей должны быть эквипотенциальными поверхностями поля G_{vac}). Кроме того, должно выполняться условие: $G_{\text{vac}}(r)$ параллельно grad $\varepsilon(r)$. Тогда $D(r) \equiv G_{\text{vac}}(r)$.
- 3. Для диэлектрика с пространственной дисперсией: если $\varepsilon_{\alpha\beta}(\boldsymbol{r}_1,\ \boldsymbol{r}_2)$ и границы раздела обладают той же симметрией, что и $\boldsymbol{G}_{\mathrm{vac}}$, то $\boldsymbol{D}(\boldsymbol{r}) \equiv \boldsymbol{G}_{\mathrm{vac}}(\boldsymbol{r})$.

В частности, это условие выполняется в системах, где границы раздела сред и их диэлектрические функции обладают той же симметрией, что и поле в вакууме $G_{\text{vac}}(r)$, определяемое распределением внешнего заряда. К таким системам относятся: 1) однородная и изотропная среда, занимающая все пространство; 2) плоская граница раздела z = 0, разделяющая среды либо с локальным откликом, либо обладающие диэлектрическими функциями, которые являются однородными и изотропными вдоль поверхности раздела, где плотность внешних зарядов зависит только от z; 3) сферически симметричная граница (или несколько сферически симметричных границ с тем же центром) r = a, разделяющая среды либо с локальным откликом, либо обладающие диэлектрическими функциями с той же сферической симметрией, где плотность внешних зарядов зависит только от r; 4) аналогичная система с цилиндрической симметрией. В случаях 2-4 при контакте двух нелокально-диэлектрических сред предполагается, что отсутствует корреляция флуктуаций поляризации в точках по разные стороны от межфазной границы, т.е. для таких значений пространственных координат диэлектрическая функция в формуле (3.2) основного текста (интегрирование в ней проводится по всему пространству):

$$D_{\alpha}(\mathbf{r}_{1}) = \int \varepsilon_{\alpha\beta}(\mathbf{r}_{1}, \mathbf{r}_{2}) E_{\beta}(\mathbf{r}_{2}) d\mathbf{r}_{2}$$

равна нулю, и это свойство автоматически выполняется и в следующих формулах (интегрирование в них тоже проводится по всему пространству):

$$\begin{split} &P_{\alpha}\left(\mathbf{r}_{1}\right) = \int \chi_{\alpha\beta}\left(\mathbf{r}_{1},\mathbf{r}_{2}\right) E_{\beta}\left(\mathbf{r}_{2}\right) \mathrm{d}\mathbf{r}_{2}, \\ &E_{\alpha}\left(\mathbf{r}_{1}\right) = \int \varepsilon_{\alpha\beta}^{-1}\left(\mathbf{r}_{1},\mathbf{r}_{2}\right) D_{\beta}\left(\mathbf{r}_{2}\right) \mathrm{d}\mathbf{r}_{2}, \\ &P_{\alpha}\left(\mathbf{r}_{1}\right) = \int \chi_{\alpha\beta}^{(\mathrm{D})}\left(\mathbf{r}_{1},\mathbf{r}_{2}\right) D_{\beta}\left(\mathbf{r}_{2}\right) \mathrm{d}\mathbf{r}_{2}, \end{split}$$

где восприимчивость среды $\chi_{\alpha\beta}^{(D)}(\pmb{r}_1,\pmb{r}_2)$ определяется соотношением:

$$\chi_{\alpha\beta}^{(D)}(\mathbf{r}_{1}-\mathbf{r}_{2}) = (4\pi)^{-1} \left[\delta_{\alpha\beta} \delta(\mathbf{r}_{1}-\mathbf{r}_{2}) - \varepsilon_{\alpha\beta}^{-1} (\mathbf{r}_{1}-\mathbf{r}_{2}) \right]. \quad (A1)$$

Тогда соотношение (A.2) дает окончательный ответ для распределения электрического поля внутри пространственной области V, занятой средой с обратной диэлектрической функцией $\varepsilon_{\alpha\beta}^{-1}(\textbf{\textit{r}}_1,\textbf{\textit{r}}_2)$:

$$E_{\alpha}(\mathbf{r}_{1}) = \int_{V} \varepsilon_{\alpha\beta}^{-1}(\mathbf{r}_{1}, \mathbf{r}_{2}) (G_{\text{vac}})_{\beta}(\mathbf{r}_{2}) d\mathbf{r}_{2}, \quad (A2)$$

где поле в вакууме, естественно, зависит только от распределения внешних зарядов, но не зависит ни от формы границы раздела, ни от диэлектрических свойств среды. Потенциал поля $\varphi(r)$ определяется согласно формуле (5), т.е. интегрированием выражения для электрического поля.

Аналогично, соотношение (А3) дает выражение для распределения поляризации среды внутри той же области V:

$$P_{\alpha}(\mathbf{r}_{1}) = \int_{V} \chi_{\alpha\beta}^{(D)}(\mathbf{r}_{1}, \mathbf{r}_{2}) (G_{\text{vac}})_{\beta}(\mathbf{r}_{2}) d\mathbf{r}_{2}.$$
 (A3)

Заметим, что для любого распределения $G_{\text{vac}}(r)$, удовлетворяющего условию симметрии системы, существует соответствующее распределение плотности внешних зарядов. Поэтому формулу (А3) можно рассматривать как линейный отклик поляризации диэлектрической среды на произвольное внешнее поле. Тогда флуктуационно-диссипационная теорема выражает ядро $\chi_{\alpha\beta}^{(D)}(r_1,r_2)$ в формуле (А3) через коррелятор флуктуаций поляризации в отсутствие внешних полей $\langle P_{\alpha}(r_1,t_1) \ P_{\beta}(r_2,t_2) \rangle$, который отражает пространственно-временную структуру полярной среды [21, 43].

Если предположить, что эта структура среды остается неизменной вплоть до ее границ, то восприимчивость среды $\chi_{\alpha\beta}^{(D)}(\pmb{r}_1,\pmb{r}_2)$, однородной и изотропной вдали от ее границ, сохраняет этот вид во всей пространственной области, занятой средой, т.е. зависит только от расстояния между аргументами функции: $\chi_{\alpha\beta}^{(D)}(|\pmb{r}_1,\pmb{r}_2|)$. Согласно со-

отношению (A1) такое свойство имеет и обратная диэлектрическая функция $\varepsilon_{\alpha\beta}^{-1}(\mathbf{r}_1-\mathbf{r}_2)$, которая в этом случае связана с фурье-образом диэлектрической функции $\varepsilon(k)$ [20, 21] (интегрирование во втором равенстве (A4) по всему \mathbf{k} пространству):

$$\varepsilon_{\alpha\beta}^{-1}(\mathbf{r}_{1} - \mathbf{r}_{2}) \equiv \delta_{\alpha\beta}\varepsilon^{-1}(|\mathbf{r}_{1} - \mathbf{r}_{2}|) =
= \delta_{\alpha\beta}(2\pi)^{-3} \int [\varepsilon(k)]^{1} \exp[i\mathbf{k}(\mathbf{r}_{1} - \mathbf{r}_{2})] d\mathbf{k} = (A4)
= \delta_{\alpha\beta}(2\pi^{2}|\mathbf{r}_{1} - \mathbf{r}_{2}|)^{-1} \int_{0}^{\infty} [\varepsilon(k)^{-1}k\sin[k|\mathbf{r}_{1} - \mathbf{r}_{2}|]] d\mathbf{k}.$$

Таким образом, задание геометрии системы (в частности, пространственной области V, занятой полярной средой), фурье-образа ее диэлектрической функции в отсутствие границ $\varepsilon(k)$ и распределение электрического поля внешних зарядов в отсутствие диэлектрических сред G(r) внутри этой пространственной области V позволяют найти распределение электрического поля в присутствии диэлектрических сред E(r) по формулам (A2) и (A4).

Практически для систем, перечисленных выше (для которых индукция D(r) совпадает с полем в вакууме), решение сводится к однократным интегралам по соответствующей переменной. Поэтому это вычисление может быть легко проведено численно для любого функционального вида диэлек*трической функции*, т.е. $\varepsilon(k)$. Эта особенность данного подхода дает ему огромное преимущество по сравнению с широко используемым альтернативным методом, основанным на "диэлектрическом приближении" (DA), в котором аналогичное предположение делается относительно диэлектрической функции среды $\varepsilon_{\alpha\beta}(\pmb{r}_1,\pmb{r}_2)$ в соотношении (3), что приводит к необходимости решать интегральное уравнение для нахождения обратной диэлектрической функции в ограниченной области, где формула (А4) уже не применима.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Список обозначений

Сокращения в тексте:

NE нелокальная электростатика
LE локальная электростатика
DA диэлектрическая аппроксимация
IDA обратная диэлектрическая аппроксимация

 $\Delta W(\Delta W \le 0)$ изменение энергии сольватации иона при его переходе из свободного раствора в центр водной полости ($\Delta G = -\Delta W$: работа по переносу иона из раствора внутрь полости)